

Величина R носит назв. коэф. Холла, для её оценки использована Друде формула: $\sigma = N e^2 l / p$, где N — концентрация электронов, $p^0 = 1/\sigma$ (далее просто p). При $T \approx 300$ К обычно $H \ll H_0$ и можно пользоваться ф-лами (5) и (6). Исключение составляет Bi, у к-рого при $H \approx 3 \cdot 10^4$ Э $\Delta\rho/\rho$ велико (~ 2). Это даёт возможность использовать Bi для измерения магн. полей.

Правило Колера. Анализ эксперим. зависимости $\Delta\rho/\rho$ металлов от H у разл. проводников разной степени чистоты при разл. T привёл к обнаружению и развитию Колера, согласно к-рому $\Delta\rho/\rho$ металла — ф-ция $H_{\text{эф}} = H\rho(\theta_D)/\rho(T)$, где $\rho(\theta_D)$ — сопротивление (при $H=0$) данного металла при Дебая температуре θ_D , $\rho(T)$ — сопротивление (при $H=0$) определ. образца.

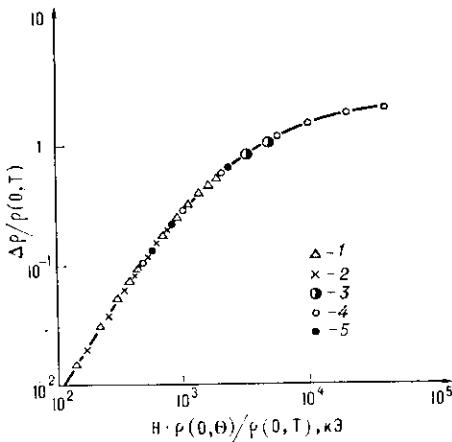


Рис. 1. Магнетосопротивление поликристаллического In в полупроводниковом магнитном поле для трёх образцов при различной температуре: 1) $T=14$ К, $\rho(T)/\rho(273)=0,24$; 2) $T=14$ К, $\rho(T)/\rho(273)=0,0086$; 3) $T=4,2$ К, $\rho(T)/\rho(273)=0,0012$; 4) $T=4,2$ К, $\rho(T)/\rho(273)=0,00007$; 5) $T=2$ К, $\rho(T)/\rho(273)=0,00003$ ($\theta_D=120$ К).

ца при темп-ре T . Величина $\rho(\theta_D)$ практически не изменяется при переходе от образца к образцу данного металла, т. к. определяется рассеянием электронов на фононах; $\rho(T)$ при $T \ll \theta_D$ существенно зависит от состояния образца — от его чистоты, наличия или отсутствия дефектов, в т. ч. дислокаций (рис. 1).

Правило Колера, сформулированное для поликристаллических образцов металлов, подтверждает представление о том, что Г. я. обусловлены искривлением траекторий электронов в магн. поле, т. к. $H_{\text{эф}}$ отличается от H/H_0 постоянным для данного металла множителем $Nec \rho(\theta_D)$.

Сильные магнитные поля. Металлы. Исследования при низких темп-рах монокристаллических образцов металлов в 1940—50-е гг. [E. Justi (E. Justi), E. S. Borovik, N. E. Алексеевский, Ю. П. Гайдуков], позволившие осуществить условие $H \gg H_0$, обнаружили разнообразные зависимости $\Delta\rho/\rho$ от величины и направления \mathbf{H} у разл. металлов. При $H \gg H_0$ Г. я. зависят от электронной энергетич. структуры металлов, в частности от формы ферми-поверхности (напр., открытая или замкнутая; рис. 2).

Вырождение электронного газа выделяет среди всех электронов металла электроны с энергией, равной энергии Ферми, т. е. расположенные в пространстве квазиимпульсов на поверхности Ферми. Т. к. при движении в магн. поле сохраняются энергия электрона и проекция его квазимпульса на \mathbf{H} , то под действием силы Лоренца электроны движутся по поверхности Ферми. Траектория электрона на поверхности Ферми — кривая, расположенная на плоскости, перпендикулярной \mathbf{H} . В зависимости от топологии поверхности Ферми траектория может быть замкнутой, а может уходить в бесконечность (рис. 3). Траектория электрона в реальном пространстве (в плоскости, перпендикуляр-

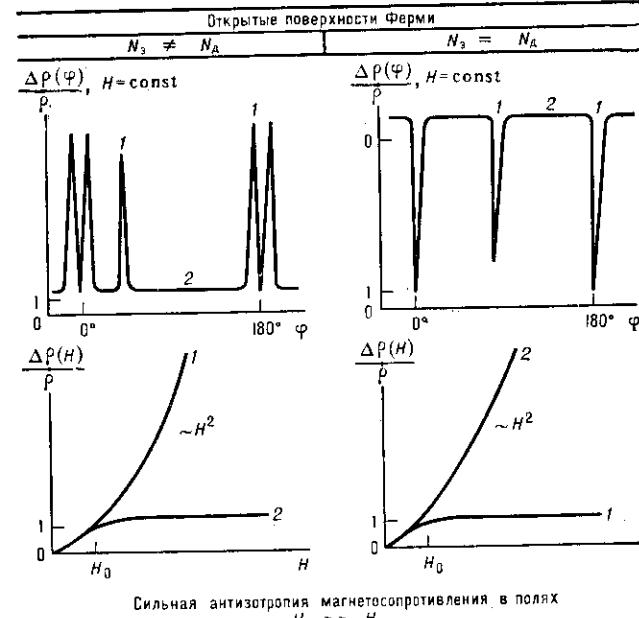
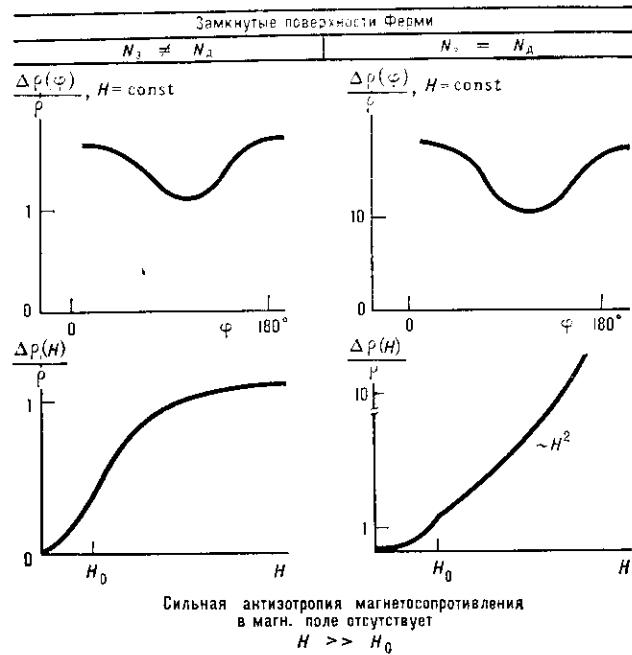


Рис. 2. Схематическое изображение зависимости поперечного магнетосопротивления $\Delta\rho/\rho$ от величины и направления магнитного поля \mathbf{H} для металлов с разной геометрией поверхности Ферми: φ — угол, задающий направление \mathbf{H} относительно кристаллографич. осей; 1 — направления, для к-рых существуют открытые траектории электронов; 2 — направления, где все траектории — замкнутые линии. N_3 — концентрация электронов проводимости, N_d — дырок.

ной \mathbf{H}) подобна его траектории на поверхности Ферми. Поэтому зависимость поперечных (относительно \mathbf{H}) компонент тензора $\mu_{ik}(\mathbf{H})$ определяется топологией поверхности Ферми. Эта зависимость, естественно, проявляется тем чётче, чем большие H отличается от H_0 , т. е. чем больше времени до столкновения электрон движется по определ. траектории (при $H \ll H_0$ он вовсе не успевает «выпрыгнуть» траекторию и его движение ме-